

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-111222
(P2002-111222A)

(43) 公開日 平成14年4月12日 (2002. 4. 12)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 0 5 K 3/46		H 0 5 K 3/46	Q 4 E 3 5 1 H 5 E 3 4 6 T B C
H 0 1 L 25/04 25/18		1/16	
審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 5 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-302193 (P2000-302193)

(22) 出願日 平成12年10月2日 (2000. 10. 2)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 木村 潤一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多層基板

(57) 【要約】

【課題】 温度変化に対して安定した多層基板を得る。

【解決手段】 樹脂基板層18、22、25、26とセラミック基板層11とが積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子12～17が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品23、24が装着されたものである。これにより、温度変化に対して安定した多層基板を得ることができる。

11 セラミック基板層

12, 15 抵抗

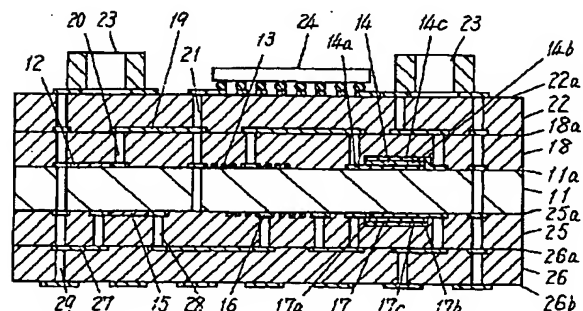
13, 16 インダクタ

14, 17 コンデンサ

18, 22, 25, 26 樹脂基板層

23 SMD部品

24 ベアチップ部品



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 樹脂基板層とセラミック基板層とが積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着された多層基板。

【請求項 2】 セラミック基板層を挟んでその両面に樹脂基板層が積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着された多層基板。

【請求項 3】 セラミック基板層にはパターンインダクタが形成された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 4】 パターンインダクタは、レーザ光線でトリミングされた請求項 3 に記載の多層基板。

【請求項 5】 セラミック基板層にはコンデンサが形成された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 6】 セラミック基板層には抵抗が形成された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 7】 抵抗は、レーザ光線でトリミングされた請求項 6 に記載の多層基板。

【請求項 8】 パターンインダクタに隣接する樹脂基板層において、前記パターンインダクタに対応するグラウンドが除去された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 9】 セラミック基板層の両面にインピーダンス素子が形成された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 10】 第 1 の樹脂基板層と第 2 の樹脂基板層との間にポリイミドフィルムを積層し、このポリイミドフィルムにコンデンサが形成された請求項 1 に記載の多層基板。

【請求項 11】 樹脂基板層にストリップ線路が設けられた請求項 1 に記載の多層基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話等に使用される多層基板に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来の多層基板は、図 4 に示すように全て樹脂基板層で形成されていた。例えば、第 1 層 1 にはパターンが形成されるとともに電子部品 2 が装着されていた。そして、この電子部品 2 はスルーホール 3 で第 2 層 4 或いは第 3 層 5 或いは第 4 層 6 へ導かれ、そこに形成されているインダクタ等に接続されていた。ここで、第 1 層 1 から第 4 層 6 の間は何れも樹脂 7 で形成されていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながらこのような従来の多層基板は、全ての層が樹脂基板で形成されていたので、この樹脂基板層にインダクタ等を形成すると温度変化による熱収縮が生じて、インダクタンス値が変化してしまうという問題があった。

【0004】本発明はこのような問題点を解決するもので、温度変化に対して安定した多層基板を提供することを目的としたものである。

【0005】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の多層基板は、樹脂基板層とセラミック基板層とが積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着されたものである。

【0006】これにより、温度変化に対して安定した多層基板を得ることができる。

【0007】

【発明の実施の形態】本発明の請求項 1 に記載の発明は、樹脂基板層とセラミック基板層とが積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着された多層基板であり、セラミック基板層にインピーダンス素子が形成されているので、温度変化に対して安定するとともに正確な値を維持することができる。

【0008】また、セラミック基板層にインピーダンス素子を形成し、樹脂基板層に電子部品を装着するので、基板の実装密度が向上し小型化が可能となる。

【0009】更にまた、セラミック基板層を一部に設けているので、多層基板としての湾曲は少ない。更に、価格が安い樹脂基板層と積層しているため、低価格の多層基板を提供することができる。

【0010】請求項 2 に記載の発明は、セラミック基板層を挟んでその両面に樹脂基板層が積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着された多層基板であり、セラミック基板層を挟んでその両面に樹脂基板層が積層されているので、多層基板が反ることはなく、セット側の親基板に隙間なく装着することができる。

【0011】また、セット側の親基板が樹脂基板であったとしても、この多層基板の外側にはセット側の親基板の熱膨張率に近い樹脂基板層を選定することで、しっかりと装着させることができる。

【0012】請求項 3 に記載の発明は、セラミック基板層にはパターンインダクタが形成された請求項 1 に記載の多層基板であり、セラミック基板層は誘電率が大きいので、このセラミック基板層に設けられたインダクタンスの小型化を図ることができる。

【0013】請求項 4 に記載の発明のパターンインダクタは、レーザ光線でトリミングされた請求項 3 に記載の多層基板であり、正確なインダクタンス値に調整できるとともに、安定したインダクタを得ることができる。

【0014】請求項 5 に記載の発明は、セラミック基板

層にはコンデンサが形成された請求項1に記載の多層基板であり、セラミック基板層は誘電率が大きいので、このセラミック基板層をはさんで電極を設けることで、コンデンサの小型化を図ることができる。

【0015】また、セラミック基板層は耐熱性が高いので、印刷法により電極と誘電体層を形成し焼成することでコンデンサ素子をつくることもできる。

【0016】請求項6に記載の発明は、セラミック基板層には抵抗が形成された請求項1に記載の多層基板であり、セラミック基板に形成されているので、温度変化に対して安定した抵抗を得ることができる。

【0017】請求項7に記載の発明の抵抗は、レーザ光線でトリミングされた請求項6に記載の多層基板であり、正確な抵抗値に調節できる。

【0018】請求項8に記載の発明は、パターンインダクタに隣接する樹脂基板層において、前記パターンインダクタに対応するグラウンドが除去された請求項1に記載の多層基板であり、パターンインダクタの近傍にグラウンドがないので、インダクタのキュー(Q)を高くすることができる。

【0019】請求項9に記載の発明は、セラミック基板層の両面にインピーダンス素子が形成された請求項1に記載の多層基板であり、両面にインピーダンス素子を形成するので、実装密度が向上し小型化を図ることができる。また、セラミック基板層に形成されているので温度安定度が高い。

【0020】請求項10に記載の発明は、第1の樹脂基板層と第2の樹脂基板層との間にポリイミドフィルムを積層し、このポリイミドフィルムにコンデンサが蒸着法で形成された請求項1に記載の多層基板であり、コンデンサの値の高精度なものが形成できるとともに薄型化を図ることができる。

【0021】請求項11に記載の発明は、樹脂基板層にストリップ線路が設けられた請求項1に記載の多層基板であり、誘電率の低い樹脂基板層にストリップ線路が設けられているので、ストリップ線路の幅を広くすることができ、抵抗分が減少し損失を少なくすることができる。この性質は特に高周波性能においてはNF特性を改善することができて好ましい。

【0022】以下、図面に従って、本発明の一実施の形態を説明する。

【0023】(実施の形態1) 図1において、11は誘電率は約10(1MHz)のセラミック基板層であり、その上面層(第3層)11aには抵抗12、インダクタ13、コンデンサ14が形成されている。また、下面層(第4層)25aも同様に抵抗15、インダクタ16、コンデンサ17が形成されている。このように、セラミック基板層11の両側にインピーダンス素子が形成されているので、外部の温度変化に対して安定したインピーダンス素子を形成することができる。

【0024】18は誘電率は約4(1MHz)の樹脂基板層であり、その上面層(第2層)18aにはパターン19が設けられている。このパターン19はインタースティシャルバイアホール(以後、ホールという)20で第3層11aやホール21で第1層22aに導出されて回路に接続される。また、この第2層18aにストリップ線路を形成すると、樹脂基板層18や22の誘電率がセラミック基板層11に比べて低いので、線路幅を広くすることができ損失を少なくすることができる。

【0025】22は誘電率は約4(1MHz)の樹脂基板層であり、その上面層(第1層)22aにはSMD部品23やベアチップ部品24が装着されている。

【0026】同様に、25、26は誘電率は約4(1MHz)の樹脂基板層であり、第5層目26aには、パターン27が設けられている。このパターン27はホール28で第4層25aやホール29で第6層26bに導出されて回路に接続される。また、このホール29は第1層22aから第6層26bまで(多層基板の表面から裏面まで)貫通するスルーホールでもある。

【0027】このように本実施の形態1における多層基板は6層構造になっており、その中心にはコア基板としてセラミック基板層11を設け、その両側には樹脂基板層18、22、25、26を設けているので、以下のような特徴を有する。即ち、セラミック基板層11に抵抗12、15とインダクタ13、16が形成されているので、温度変化に対して安定するとともに正確な値を維持することができる。

【0028】また、第1層22aにはSMD部品23やベアチップ部品24を装着するので、実装密度が向上し小型化が可能となる。

【0029】更にまた、セラミック基板層11を挟んでその両面に樹脂基板層18、22、25、26が積層されているので、多層基板が反ることはなくセット側の親基板に隙間なく装着させることができる。

【0030】また、セット側の親基板が樹脂基板であったとしても、この多層基板と前記親基板との接触側はセット側の基板の熱膨張率に近い熱膨張率を有する樹脂基板層を選定しているので、しっくり装着させることができる。

【0031】図2はセラミック基板層11の上面の第3層11aに形成されたインピーダンス部品の斜視図である。図2において、抵抗12、インダクタ13、コンデンサ14である。ここで、抵抗12やインダクタ13はレーザ光線でトリミングされるので、正確な抵抗値と正確なインダクタンス値に調整できるとともに、安定した性能を得ることができる。また、このインダクタ13は誘電率の大きなセラミック基板層11に形成されているので、小型で大きなインダクタンス値を得ることができる。

【0032】また、このインダクタ13の上方第2層1

8aにおいては、グランドパターンを不形成とすれば、インダクタ13のQを高くすることができる。

【0033】コンデンサ14、17は、電極層14a、14c、17a、17c、誘電体層14b、17bを印刷・焼成で形成されている。誘電体層14b、17bに高誘電体の材料を用いているので、小型で大きなキャパシタンス値を得ることができる。

【0034】（実施の形態2）実施の形態2は、実施の形態1の第5層26aに図3に示すように、ポリイミドフィルム30で形成された第5層30aと樹脂基板層31で形成された第6層31aを挿入し、全部で第8層とした多層基板の断面図である。

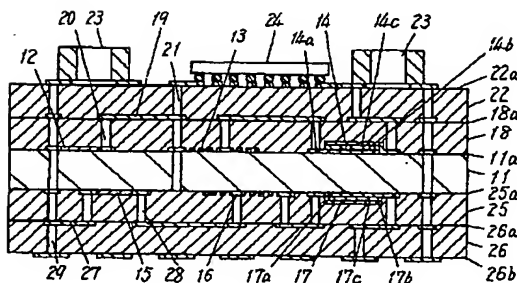
【0035】図3において、32はポリイミドフィルム30の第6層31aに形成されたコンデンサである。ポリイミドフィルム30に蒸着法で形成されているので、コンデンサ32の値の高精度なものが形成できるとともに薄型化を図ることができる。

【0036】

【発明の効果】以上のように本発明の多層基板は、樹脂基板層とセラミック基板層とが積層された多層基板であって、前記セラミック基板層にはインピーダンス素子が形成されるとともに、前記樹脂基板層の最上層には電子部品が装着された多層基板であり、セラミック基板にインピーダンス素子が形成されているので、温度変化に対して安定するとともに正確な値を維持することができる。

【図1】

- 11 セラミック基板層
- 12, 15 抵抗
- 13, 16 インダクタ
- 14, 17 コンデンサ
- 18, 22, 25, 26 樹脂基板層
- 23 SMD部品
- 24 ベアチップ部品



【0037】また、セラミック基板層にインピーダンス素子を形成し、樹脂基板層に電子部品を装着するので、基板の実装密度が向上し小型化が可能となる。

【0038】更にまた、セラミック基板層を一部に設けているので、多層基板としての湾曲は少ない。更に、価格が安い樹脂基板層と積層しているので、低価格の多層基板を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1による多層基板の断面図

【図2】同、要部斜視図

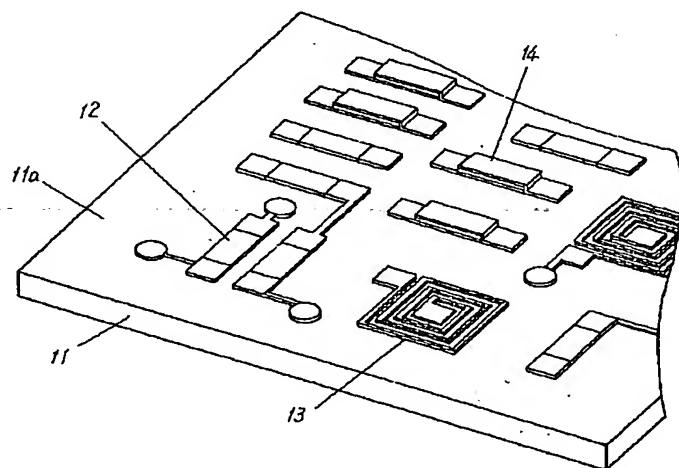
【図3】本発明の実施の形態2による多層基板の断面図

【図4】従来の多層基板の断面図

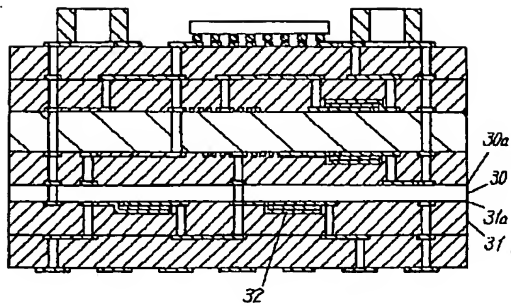
【符号の説明】

- 11 セラミック基板層
- 12 抵抗
- 13 インダクタ
- 14 コンデンサ
- 15 抵抗
- 16 インダクタ
- 17 コンデンサ
- 18 樹脂基板層
- 22 樹脂基板層
- 23 SMD部品
- 24 ベアチップ部品
- 25 樹脂基板層
- 26 樹脂基板層

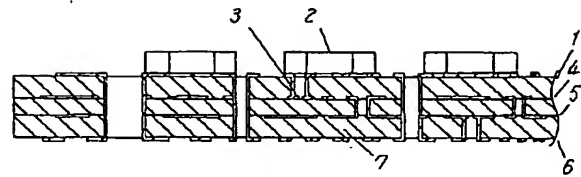
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

H 0 5 K 1/16

識別記号

F I

H 0 5 K 1/16

H 0 1 L 25/04

ターマコード (参考)

D

Z

F ターム (参考) 4E351 AA01 AA07 BB03 BB05 BB09
BB24 BB26 FF04 FF18 GG01
GG06 GG09
5E346 AA02 AA04 AA12 AA13 AA15
AA23 AA27 AA29 AA32 AA33
AA36 AA42 AA43 BB20 CC08
CC16 CC21 EE20 FF01 FF27
FF45 GG15 GG28 HH02 HH11
HH16 HH22